



| 兵工学报 > > 兵工学报中文刊 > > MBE生长高功率列阵激光器的研究 作者: 李忠辉 王玲 王玉霞 杨进华 张兴德 [评论](#)

2002年第3期 总第23期(卷) 研究简报 文章来源: (长春理工大学高功率半导体激光国家重点实验室, 吉林长春, 130022)

MBE生长高功率列阵激光器的研究

2005-2-18 13:37:38 中国兵工学会

摘要: 利用V80型MBE生长GaAlAs / GaAs梯度折射率分别限制单量子阱 (GRIN-SCH-SQW) 结构。测试结果表明, 该结构晶格和光学质量符合设计要求。制成激光器列阵, 室温连续输出功率达7.2W, 峰值波长为807-809nm, 经柱透镜光纤耦合后的光强远场分布为 $Q_{//}=8$, $Q_{\perp}=3.5$

关键词: 分子束外延; 列阵激光器; 分别限制; 量子阱

中图分类号: TN248.4

发布人: admin

发布时间: 2005年2月18日

共有1230位读者阅读过此文

- [上篇文章: 现场可控非致命的次声武器研究](#)
- [下篇文章: 机动武器系统的含间隙动力学研究——下篇: 系统仿真](#)

□- 本周热门文章

1. 机动武器系统的含间隙动力学研究——下...[]

□- 相关文章 [研究简报](#)

[关于我们](#) | [联系我们](#) | [网站声明](#) | [经营业务](#) | [相关链接](#) | [使用帮助](#)



中国兵工学会 版权所有 2003-2004

Copyright All Reserved by China Ordnance Society. 2003-2004